

Revendicare:

Procedeu de preparare a heterojoncțiunilor $p^+InP-pInP/CdS$ și $p^+GaAs-pGaAs/CdS$, ce include creșterea structurilor $p^+InP-pInP$ și $p^+GaAs-pGaAs$ în sistem de cloruri cu transport de gaze, decaparea chimică, plasarea structurilor în reactor, purjarea reactorului cu hidrogen, încălzirea cuptorului electric, creșterea stratului CdS, **caracterizat prin aceea că** procesul de creștere a stratului CdS se efectuează după amplasarea reactorului în cuptor și stabilizarea temperaturilor, după aceasta reactorul este scos din cuptor, totodată, în timpul creșterii debitele fluxului de hidrogen în zona sursei și în zona de creștere sunt respectiv de $150\text{ cm}^3/\text{min}$ și $220\text{...}240\text{ cm}^3/\text{min}$, iar în timpul stabilizării temperaturii și în timpul răcirii respectiv de $20\text{...}30\text{ cm}^3/\text{min}$ și $1000\text{ cm}^3/\text{min}$.